

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр
Российской академии наук "Издательство "Наука" (Санкт-Петербург)

Переводная версия: Semiconductors

Том: 50 Номер: 10 Год: 2016

<u>Название статьи</u>	<u>Страницы</u>	<u>Цит.</u>
ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ		
<u>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ $TlIn_{1-x}Vb_xTe_2$</u>	1297-1302	
<i>Алиев Ф.Ф., Агаева У.М., Зарбалиев М.М.</i>		
<u>FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS OF THE ELECTRONIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF GaSb</u>	1303-1308	
<i>Castano-Gonzalez E.E., Sena N., Mendoza-Estrada V., Gonzalez-Hernandez R., Dussan A., Mesa F.</i>		
<u>ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНИЯ</u>	1309-1312	
<i>Подкопаев О.И., Шиманский А.Ф., Копыткова С.А., Филатов Р.А., Голубовская Н.О.</i>		
<u>SOME CHALLENGING POINTS IN THE IDENTIFICATION OF DEFECTS IN FLOATING-ZONE N-TYPE SILICON IRRADIATED WITH 8 AND 15 MEV PROTONS</u>	1313-1319	
<i>Emtsev V.V., Abrosimov N.V., Kozlovskii V.V., Oqanesyan G.A., Poloskin D.S.</i>		
<u>ГЕНЕРАЦИЯ КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРОВ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 5.8 МКМ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ</u>	1320-1324	
<i>Бабичев А.В., Bousseksou A., Пихтин Н.А., Тарасов И.С., Никитина Е.В., Софронов А.Н., Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е., Новиков И.И., Карачинский Л.Я., Егоров А.Ю.</i>		
СПЕКТРОСКОПИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗЛУЧЕНИЯМИ		
<u>ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ В УФ- И ИК-ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА В ПЛЕНКАХ, НАНОСТЕРЖНЯХ, ОБЪЕМНЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ ZnO, ЛЕГИРОВАННЫХ ER И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННЫМИ ПРИМЕСЯМИ</u>	1325-1332	
<i>Мездрогина М.М., Виноградов А.Я., Кузьмин Р.В., Левицкий В.С., Кожанова Ю.В., Лянгузов Н.В., Чукичев М.В.</i>		
<u>АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ МОДУЛЯЦИИ ЗАСЕЛЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОНАМИ, СОЗДАВАЕМОЙ ПИКОСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ЗОНДИРУЮЩЕГО И СОБСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ В GaAs</u>	1333-1342	
<i>Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Забегаев Д.Н., Кривоносов А.Н.</i>		
<u>ОТРАЖЕНИЕ КРИСТАЛЛА PbSb₂Te₄ В ШИРОКОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ</u>	1343-1347	
<i>Немов С.А., Улашкевич Ю.В., Поволоцкий А.В., Хламов И.И.</i>		
ПОВЕРХНОСТЬ, ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ		
<u>СПЕКТРОСКОПИЯ ОСТОВНОГО УРОВНЯ АТОМОВ УГЛЕРОДА С 1S НА ПОВЕРХНОСТИ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО СЛОЯ SiC/Si(111) 4° И ИНТЕРФЕЙСА CS/SiC/Si(111) 4°</u>	1348-1352	
<i>Бенеманская Г.В., Деметьев П.А., Кукушкин С.А., Лапушкин М.Н., Осипов А.В., Сеньковский Б.В.</i>		
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СТРУКТУРЫ, НИЗКОРАЗМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ		
<u>ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ ДНК НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР</u>	1353-1357	
<i>Баграев Н.Т., Чернев А.Л., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Емельянов А.К., Дубина М.В.</i>		
ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ		
<u>ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ($\lambda = 1550$ НМ) НА ОСНОВЕ GaSb: МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	1358-1362	
<i>Хвостиков В.П., Сорокина С.В., Хвостикова О.А., Левин Р.В., Пушный Б.В., Тимошина Н.Х., Андреев В.М.</i>		
<u>ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЛОЕВ Cu-In-Ga-Se НА ФОТОПРОВОДИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНВЕРСИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Cds/CdSe</u>	1363-1369	
<i>Новиков Г.Ф., Tsai W.T., Бочаров К.В., Рабенко Е.В., Jeng M.J., Chang L.Be.</i>		
<u>МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОПЛАЗМ ПРИ ЛАВИННОМ ПРОБОЕ P-N-СТРУКТУР КРЕМНИЯ</u>	1370-1373	
<i>Мусаев А.М.</i>		
<u>ОСНОВНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХПЕРЕХОДНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ InGaP/InGaAs/Ge В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ($-197 \leq T \leq +85^\circ\text{C}$)</u>	1374-1379	
<i>Андреев В.М., Малевский Д.А., Покровский П.В., Румянцев В.Д., Чекалин А.В.</i>		
<u>ТЕОРИЯ МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРОВ НА КВАНТОВОЙ ЯМЕ С АСИММЕТРИЧНЫМИ БАРЬЕРНЫМИ СЛОЯМИ: УЧЕТ АСИММЕТРИИ ЗАПОЛНЕНИЯ</u>	1380-1386	

ЭЛЕКТРОННЫХ И ДЫРОЧНЫХ СОСТОЯНИЙ*Асрян Л.В., Зубов Ф.И., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Жуков А.Е.***ПАДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ GAN-СВЕТОДИОДОВ ПРИ ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ИНЖЕКЦИИ: РОЛЬ ВОДОРОДА**

1387-1394

*Бочкарева Н.И., Шеремет И.А., Шретер Ю.Г.***ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО КВАНТОВО-КАСКАДНОГО ЛАЗЕРА С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВОЛНОВОДОМ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР GAAS/ALGAAS**

1395-1400

*Хабибуллин Р.А., Щаврук Н.В., Павлов А.Ю., Пономарев Д.С., Томаш К.Н., Галиев Р.Р., Мальцев П.П., Жуков А.Е., Цырлин Г.Э., Зубов Ф.И., Алфёров Ж.И.***ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕТЕРОСТРУКТУР ALN/GAN/ALGAN И ALN/GAN/INAlN С ДВУМЕРНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ГАЗОМ НА ИХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ**

1401-1407

*Цацульников А.Ф., Лундин В.В., Заварин Е.Е., Яговкина М.А., Сахаров А.В., Усов С.О., Земляков В.Е., Егоркин В.И., Булашевич К.А., Карпов С.Ю., Устинов В.М.***ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИХ ЛАЗЕРОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 850 НМ С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМИ КОНТАКТАМИ И РОМБОВИДНОЙ ОКСИДНОЙ ТОКОВОЙ АПЕРТУРОЙ**

1408-1413

*Бобров М.А., Малеев Н.А., Блохин С.А., Кузьменков А.Г., Блохин А.А., Васильев А.П., Гусева Ю.А., Кулагина М.М., Задиранов Ю.М., Трошков С.И., Лисак В., Устинов В.М.***ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ С РАСШИРЕННЫМ ВОЛНОВОДОМ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (110-120 К)**

1414-1419

*Веселов Д.А., Шашкин И.С., Бобрецова Ю.К., Бахвалов К.В., Лютецкий А.В., Капитонов В.А., Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Соколова Э.Н., Тарасов И.С.***ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОДИОДОВ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА**

1420-1424

*Куницына Е.В., Гребенщикова Е.А., Коновалов Г.Г., Андреев И.А., Яковлев Ю.П.***ЛАЗЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКЦИОННОГО МИКРОДИСКА С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫВОДА ИЗЛУЧЕНИЯ В СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО**

1425-1428

*Зубов Ф.И., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Полубавкина Ю.С., Симчук О.И., Кулагина М.М., Задиранов Ю.М., Трошков С.И., Липовский А.А., Максимов М.В., Жуков А.Е.***УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА "ТОНКИХ" УПРУГО НАПРЯЖЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ INGAAS/INGAALAS, ИЗЛУЧАЮЩИХ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ВБЛИЗИ 1550 НМ**

1429-1433

*Новиков И.И., Карачинский Л.Я., Колодезный Е.С., Бугров В.Е., Курочкин А.С., Гладышев А.Г., Бабичев А.В., Гаджиев И.М., Буяло М.С., Задиранов Ю.М., Усикова А.А., Шерняков Ю.М., Савельев А.В., Няпшаев И.А., Егоров А.Ю.***ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР****ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕМТ ALGAN/ALN/GAN С ПАССИВАЦИЕЙ Si_3N_4 IN SITU**

1434-1438

Томаш К.Н., Павлов А.Ю., Павлов В.Ю., Хабибуллин Р.А., Арутюнян С.С., Мальцев П.П.